

「IV 族系半導体の製膜と低温結晶化（固相結晶化を中心）」

9月7日(木) 13:00 開始 (予定)

企画の趣旨

ディスプレイの駆動デバイスとして用いられている半導体薄膜トランジスタ (TFT) において、Si 等の IV 族材料は重要な位置を占めています。Si 系 TFT の研究開発では、大面積パネルでは非晶質 Si (a-Si:H) が主流ですが、小型パネルを中心として多結晶 Si へと変遷してきています。今回のシンポジウムでは、製膜法も含めて基本的な固相結晶化法を中心に、Si に加えて Ge 系材料など IV 族半導体薄膜を包括的に討論します。

これまでこの分野で貢献された研究者、現在、推進されている研究者に話しをしていただき、議論を深め、今後の FPD や LSI 等への応用、発展への指針を得たいと考えています。

一般講演も募集致します。多数の皆様のご来場をお待ちしております。

招待講演者（敬称略）と講演内容

1. 水島一郎 (東芝) 「CVD-Si 薄膜の結晶化と電気的特性」
2. 雲見英也 (東工大、元キャノン) 「多結晶 Si 薄膜形成における結晶核形成の動力学と位置制御」
3. 浅野種正 (九州大) 「位置制御 SPC による Si TFT の高性能化」
4. 斎藤一也 (ULVAC) 「LTPS 用 CVD 成膜技術」
5. 仲村龍介 (大阪府大) 「アモルファス Ge 薄膜の結晶化における安定相と準安定相の競合」
6. 浦岡行治 (NAIST) 「金属ナノ触媒を利用した非晶質シリコンの結晶化とそのデバイス応用」
7. 佐道泰造 (九州大) 「金属触媒を用いた IV 族半導体/絶縁膜の低温成長」
世話人：松尾直人(兵庫県立大)、野口隆(琉球大)、